УДК 536.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ ПЕРЕНОСА НА БАЗЕ МОЛЕКУЛЯРНО-РАДИАЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Никитенко Н. И.

Институт технической теплофизики НАН Украины, г. Киев

Излагаются активационные механизмы переноса субстанции в твердых и жидких средах. Представлены аналитические выражения для электронной, фотонной и диффузионной теплопроводности и результаты их сопоставления с экспериментальными данными.

The activation mechanisms of transfer of a substance in solid and liquid environments are stated. Analytical expressions for electronic, photonic and diffusion heat conductivity and results of their comparison to experimental data are submitted.

Ключевые слова: механизмы переноса теплоты и массы, плотность свободных электронов.

К настоящему времени сформулировано нескольких механизмов переноса энергии в конденсированных телах. Коэффициент теплопроводности реального тела считается равным сумме отдельных составляющих, отвечающих различными механизмами переноса. Обычно полагают, что перенос энергии в диэлектриках осуществляется звуковыми волнами, каждой из которых ставится в соответствие квазичастица – фонон определенной частоты. Путем подстановки в выражение для теплопроводности $\lambda_{\rm r} = n_{\rm r} w_{\rm r} l_{\rm r} c_{\rm r} / 3$, полученное на базе элементарной кинетической теории газов, вместо скорости газа $w_{\rm r}$ значения скорости звука w_3 , а вместо $c_{\rm r}$ – величины удельной теплоемкости конденсированного тела, приходят к выражению теплопроводности для диэлектриков. Однако фононы не являются материальными носителями. Поэтому такой механизм теплопроводности не является достаточно обоснованным.

Классическая теория электронной теплопроводности (теория Друде) базируется на предположении [6, 7], что все валентные электроны являются свободными, они не взаимодействуют с положительно заряженными ионами и подчиняются законам идеального газа. Если кинетическая энергия свободного электрона E_3 равна средней кинетической энергии атомов газа, т.е. $E_3 = 3kT/2 = m_3w_3^2/2$, то теплоемкость электрона $c_3 = 3k/2$ и тогда $n_3 = w_3n_3l_3k/2$. Полученное Друде выражение n_3 удовлетворительно согласуется с экспериментом лишь в некотором интервале температур. В квантовой теории электронной теплопроводности также считается, что все валентные электроны свободны и не взаимодействуют с ионами и другими электронами. Для получения выражений для n_3 требуется задание зависимости скорости и энергии электронов от волнового вектора. Используемые при этом допущения оправдываются лишь в ограниченном интервале температур. Ни теория Друде ни квантовая теория не смогла объяснить того, что в области весьма низких температур n_3 имеет максимум, который может на порядок превышать значение теплопроводности при комнатной температуре.

Существенное влияние на теплопроводность л конденсированных тел оказывают активационные процессы. Они характеризующиеся тем, что при возрастании температуры вследствие флуктуационных процессов быстро увеличивается число частиц, которые достигают энергетического уровня, достаточного для качественного изменения состояния частицы, в частности для разрыва связей с соседними частицами и совершения диффузионного перескока в окружение других частиц. Природа флуктуационных процессов до недавнего времени оставалась неясной.

В работах автора [1–5] построены основы молекулярно-радиационной теории тепло- и массопереноса, базирующейся на концепции переноса энергии материальными носителями, непрерывно испускаемыми и поглощаемыми частицами вещества. В отличие от классической теории, эта теория позволяет получить как уравнения переноса, так и выражения для параметров переноса через характеристики частиц тела. На основе указанной концепции получено интегродифференциальное уравнение переноса энергии. В результате использования закона сохранения энергии и экспериментально установленного факта независимости отношения λ к удельной объемной теплоемкости c_V от температуры для аморфных тел,

найден линейный закон зависимости интенсивности испускания энергии частицами тела от их энергии, отсчитываемой от нулевого уровня. При этом интегродифференциальное уравнение переноса в пределе переходит в уравнение теплопроводности Фурье и гиперболическое уравнение переноса.

В рамках молекулярно-радиационной теории для систем, в которых носителями энергии являются фотоны, найден [1] следующий закон интенсивности спектрального излучения частиц тела: частицы единичного объема тела, находящиеся на энергетическом уровне i по частоте колебаний н, излучают за единицу времени квантами энергию q_{ih} , величина которой пропорциональна энергетическому уровню i, энергии кванта hн и плотности находящихся на этом уровне частиц n_{ih} , т.е.

$$q_{i\mathrm{H}} = \mathrm{e}_{\mathrm{H}}ih\mathrm{H}n_{i\mathrm{H}}.$$

Из закона Никитенко (1) вытекают [2] формула Планка для спектрального излучения черного макроскопического тела в состоянии равновесия и закон Максвелла-Больцмана о распределении частиц тела по энергиям. Закон (1) справедлив для случая, когда $n_{iv} = 1$, поэтому он является элементарным. Из интегродифференциального уравнения переноса энергии фотонами следует формула для удельной теплоемкости многокомпонентного тела, которая хорошо согласуется с экспериментом и в пределе переходит в формулу Дебая.

На базе (1) найдена [2] функция распределения частиц, поглощающих и излучающих фотоны частоты н, по энергиям в активационных процессах

$$W_{\rm BiH} = \left[1 - \exp\left(-\frac{h_{\rm H}}{kT}\right)\right] \left[1 - \exp\left(-\frac{(I_{\rm BH} + 1)h_{\rm H}}{kT}\right)\right]^{-1} \exp\left(-\frac{ihv}{kT}\right), \ i = 0, 1, \dots, I_{\rm BH}.$$
 (2)

Предельный уровень энергии $I_{\beta\nu}$, на котором может находиться частица компонента в в активационных процессах, определяется из условия $I_{\beta\nu}h\nu < A_{\beta} \leq (I_{\beta\nu} + 1)h\nu$. После поглощения фотона $h\nu$ частица, расположенная на уровне $I_{\beta\nu}$, активизируется и, отдавая энергию $(I_{BH} + 1)h\nu$, совершает диффузионный перескок. При $I_{\beta\nu} \rightarrow \infty$ функция распределения Никитенко (2) переходит в закон распределения Максвелла-Больцмана. На основе (1), (2) получены [2] формула для массы частиц компонента в из единичного объема, достигающих в единицу времени энергии активации:

$$G_{\beta} = \varepsilon_{\beta} \rho_{\beta} / \left[\exp(A_{\beta} / kT) - 1 \right]$$
(3)

и формула для коэффициента диффузии в конденсированных средах

$$D_{\beta} = a_{\beta}^{2} \varepsilon_{\beta} / \left\{ 3 \left[\exp\left(A_{\beta} / kT\right) - 1 \right] \right\}, \tag{4}$$

При $A_{\beta} / RT >> 1$ формула Никитенко (4) переходит в эмпирическую формулу Аррениуса для твердых, а при $A_{\beta} / RT << 1$ – в формулу Эйнштейна для жидких сред. С помощью (1) – (3) получены [3–5] формулы для интенсивности испарения в зависимости от температуры и толщины испаряющегося слоя, и для равновесной толщины конденсированного слоя не твердой поверхности.

Ниже излагаются результаты исследования механизмов теплопроводности в диэлектриках и металлах на базе молекулярно-радиационной теории переноса.

Фотонный механизм теплопроводности. Для определения коэффициента теплопроводности однородного изотропного многокомпонентного тела в зависимости от температуры и микроскопических характеристик его частиц достаточно рассмотреть плоскую пластину в стационарном неравновесном состоянии. Направим ось x вдоль нормали к граничной поверхности пластины, а ось y – вдоль этой поверхности. Температурное поле в пластине выражается зависимостью T = T(x). Плотность потока энергии q через площадку ДS, которая лежит в плоскости x и ее центральная точка имеет координаты (x, y = 0), определяется следующим образом. Вначале находится плотность потока энергии dq, испускаемой элементарным изотермическим слоем d3 с координатой x+3, который удален от площадки ДS на расстояние 3. Средняя энергия частицы в слое d3, излучающей и поглощающей фотоны hн, равна $[1] e_{\rm H} = h{\rm exp}[h{\rm h}/[kT(x+3)]-1]]^{-1}$. Выделим в слое d3 элемент в виде кольца радиуса y, толщиной dy и шириной d3. Плотность потока энергии $d^2q_{\rm BH}$ через площадку ДS, который обусловлен испусканием фотонов $h\nu$ частицами сорта β , расположенными в объеме элемента 2 $\pi y dy d\eta$, составит

$$d^2 q_{\rm BH} = -\cos(6) 2py dy d_3 n_{\rm BH} e_{\rm BH} e_{\rm H} H_{\rm H}(3).$$
⁽⁵⁾

103

Здесь косинус угла а между осью *x* и радиус-вектором *r*, направленным из центра площадки ΔS в точку $(x+\eta, y)$ рассматриваемого элемента, равен $\cos 6 = 3 / \sqrt{y^2 + 3^2}$; $\prod_{BH} (3) = o_{BH} \exp(-o_{BH}F_H3)/(4p3^2)$; $F_H = \sum_B y_{BH}n_{BH}$; о — коэффициент перекрытия, 0< о <1. Для аморфных тел о ≈ 1. Производя интегрирование (5) по переменной *y* во всем возможном интервале ее изменения 0 < *y* < ∞, находим плотность теплового потока dq_{BH} через площадку ΔS , обусловленным излучением фотонов *h* н частицами сорта в из слоя *d*з

$$dq_{\rm BH} = \int_{\nu=0}^{\infty} d^2 q_{\rm BH} = -\frac{1}{2} n_{\rm BH} e_{\rm BH} e_{\rm H} \Big[\exp(-o_{\rm BH} F_{\rm H} 3) + o_{\rm BH} F_{\rm H} 3 Ei(-o_{\rm BH} F_{\rm H} 3) \Big] d3 .$$
(6)

Результирующая плотность теплового потока $q_{\beta\nu}$ определяется как разность потоков энергии, проходящих через площадку ΔS в положительном и отрицательном направлении оси x. Нахождение $q_{\rm BH}$ связано с интегрированием (6) по толщине пластины. Однако благодаря тому, что входящие в (6) экспоненциальная функция и интегральная показательная функция *Ei* весьма быстро убывают при возрастании их аргумента, можно интегрирование по толщине пластины заменить интегрированием в неограниченном интервале. Тогда получаем

$$q_{\rm BH} = \frac{1}{2} c_{\rm H} n_{\rm BH} e_{\rm BH} \int_{0}^{\infty} \left[e_{\rm H}(x+3) - e_{\rm H}(x-3) \right] \left[\exp(-o_{\rm BH} F_{\rm H} 3) + o_{\rm BH} F_{\rm H} 3 Ei(-o_{\rm BH} F_{\rm H} 3) \right] d3$$

В соответствии с формулой Тейлора $e_{\rm H}(x+3) - e_{\rm H}(x-3) \approx 23 \partial e_{\rm H}(x) / \partial x = 23 c_{\rm H} \partial T(x) / \partial x$, где $c_{\rm H}$ - те-плоемкость, приходящаяся на одну степень свободы,

$$c_{\nu} = \partial e_{\nu}(x) / \partial T = h\nu \left[\exp(h\nu / kT) - 1 \right]^{-2} \left(h\nu / kT^{2} \right) \exp(h\nu / kT),$$
(7)

находим

$$q_{\rm BH} = -\frac{1}{3} \frac{n_{\rm BH} e_{\rm BH} c_{\rm H}}{o_{\rm BH}^2 F_{\rm H}^2} \frac{\partial T}{\partial x}, \qquad (8)$$

Общая плотность потока энергии фотонов через площадку Д*S* определяется путем интегрирования по всем частотам в интервале $[0, H_{B max}]$ выражения (8), в предположении, что плотность степеней свободы частиц компонента в , колеблющихся с частотой v , равна [2] $dn_{BH} = \Gamma_B 8 \text{ph}^2 d\text{H} / c^3$, а затем суммирования по всем компонентам тела

$$q = \frac{8p}{3c^3} \frac{\partial T}{\partial x} \sum_{B=1}^{B} \Gamma_B \int_{H=0}^{H_B \max} \frac{e_{BH} H^2 c_H}{o_{BH}^2 F_H^2} dH.$$
(9)

Здесь $\gamma_{\beta\nu} = f(\nu)$ – вероятное число степеней свободы атомов компонента в , образующих стоячую волну с частотой ν [2], $\Gamma_{BH} = 9n_Bc^3/(8pH_{Bmax})$; H_{Bmax} — максимальная частота стоячих электромагнитных волн, реализуемых в конденсированном теле. Подставим в (9) значение γ_{β} и выражение (7) для c_{ν} , введем осредненное по частотам выражение комплекса величин согласно соотношению $\frac{e_B}{o_B^2 F^2} = \int_{H=0}^{H_Bmax} \frac{e_{BH}H^2c_H}{o_{BH}^2 F_H^2} dH / \int_{H=0}^{H_Bmax} c_H dH$, новую переменную $z = \frac{hH_Bmax}{kT}$ и обозначение $u_B = hH_Bmax / k$, затем

разделим (9) на градиент температуры $\partial T / \partial x$. В результате приходим к формуле для коэффициента фотонной теплопроводности

$$\pi_{\phi} = 3k \sum_{B=1}^{B} \frac{n_{B}e_{B}}{o_{B}^{2}F^{2}} \frac{T^{3}}{\mu_{B}^{3}} \int_{0}^{B} \frac{z^{4} \exp z \, dz}{(\exp z - 1)^{2}} = \frac{1}{3} \sum_{B=1}^{B} \frac{e_{B}c_{V_{B}}}{o_{B}^{2}F^{2}}.$$
(10)

Коэффициент теплопроводности аморфных тел согласно экспериментальным данным [1] изменяется пропорционально удельной теплоемкости. Так как для аморфных тел $\xi \approx 1$, то из (10) следует, что величина π_{ϕ} пропорциональна теплоемкости. В кристаллических телах с ростом температуры ξ возрастает и

поэтому λ_{ϕ} при значении *T*, близком к θ_{β} , достигает максимума. Это находится в соответствии с экспериментальными данными для теплопроводности диэлектриков [6].

Диффузионный механизм теплопроводности. В результате обмена энергией между частицами при помощи носителей энергии – фотонов, возникает неравномерное распределение частиц по энергиям. Это распределение определяется законом (2). Те частицы тела, которые достигают энергии активации, совершают диффузионный перескок в окружение других атомов. При перескоке частицы переносят ранее накопленную энергию. Масса G_{β} частиц компонента в из единичного объема, которые за единицу времени достигают энергии активации, находится по формуле (3). Средняя диффузионная скорость атома w_{β} пропорциональна числу перескоков G_{β}/ρ_{β} , совершаемых атомом за единицу времени, и среднему расстоянию a_{β} , которое он преодолевает за один перескок, $w_{\rm B} = a_{\rm B}G_{\rm B}/c_{\rm B}$. Согласно элементарной кинетической теории плотность потока энергии, переносимой атомами сорта β через плоскость z в положительном направлении, составит $q_{\beta}^+(z) = \rho_{\beta}(z - a_{\beta})w_{\beta}(z - a_{\beta})E = a_{\beta}G_{\beta}(z - a_{\beta})E_{\beta}(z - a_{\beta})/6$, а в обратном направлении $q_{\rm B}^-(z) = a_{\rm B}G_{\rm B}(z + a_{\rm B})/6$.

Средняя удельная внутренняя энергия $E_{\rm B}$ компонента в равна [1]

$$E_{\rm B} = 9kT^4 \frac{n_{\rm B}}{\frac{3}{\rm B}} \int_{0}^{{\rm B}/T} \frac{z^3 dz}{\exp z - 1},$$
(11)

Результирующая плотность теплового потока атомов в направлении z равна

$$q_{\rm B} = q_{\rm B}^{+} - q_{\rm B}^{-} = -\frac{1}{3} a_{\rm B}^{2} \frac{\partial (G_{\rm B} E_{\rm B})}{\partial z} = -\pi_{D\rm B} \frac{\partial T}{\partial x}.$$
 (12)

Отсюда следует, что диффузионная теплопроводность

$$\pi_{D_{\rm B}} = \pi_{D_{\rm B}} = \frac{1}{3} a_{\rm B}^2 \frac{\partial (G_{\rm B} E_{\rm B})}{\partial T} = \frac{1}{3} a_{\rm B}^2 \left(G_{\rm B} \frac{\partial E_{\rm B}}{\partial T} + E_{\rm B} \frac{\partial G_{\rm B}}{\partial T} \right).$$
(13)

Объемная удельная теплоемкость $c_{V\beta}$ и производная $\partial G_{\beta} / \partial T$ равны

$$c_{V_{\rm B}} = \frac{\partial E_{\rm B}}{\partial T} = 9kn_{\rm B} \left\{ 4 \frac{T^3}{\mu_{\rm B}^3} \int_0^{\mu_{\rm B}/T} \frac{z^3 dz}{\exp z - 1} + \frac{\mu_{\rm B}}{T} \left[\exp\left(\frac{\mu_{\rm B}}{T}\right) - 1 \right]^{-1} \right\},\tag{14}$$

$$\frac{\partial G_{\beta}}{\partial T} = \varepsilon_{\beta} \rho_{\beta} \left[\exp\left(\frac{A_{\beta}}{kT}\right) - 1 \right]^{-2} \frac{A_{\beta}}{kT^{2}} \exp\left(\frac{A_{\beta}}{kT}\right).$$
(15)

Таким образом, функциональная зависимость $\pi_{DB} = f(T)$ полностью определена. Диффузионная теплопроводность многокомпонентного тела λ_D приближенно определяется путем суммирования $\lambda_{D\beta}$ по всем его компонентам. Трудность расчета $\lambda_{D\beta}$ связана с нахождением средней длины диффузионного перескока a_{β} . Наличие границ кристаллов, примесей, дислокаций, механических и тепловых воздействий приводит к уменьшению величины a_{β} вследствие рассеяния частиц, совершающих диффузионный перескок. Поэтому полагают, что в твердых телах, образованных крупными кристаллами, величина a_{β} возрастает при понижении температуры. Это подтверждается тем, что для температур, превышающих $u_{\rm B}$, когда теплоемкость c_V близка к значению 3 k, наблюдается увеличение теплопроводности кристаллических тел при понижении температуры. Когда температура приближается к значению θ_{β} , величина $\lambda_{D\beta}$ достигает максимального значения. С понижением температуры a_{β} возрастает до размера кристалла. Дальнейшее снижение температуры не приводит к изменению a_{β} . Поэтому при низких температурах $\lambda_{D\beta}$ изменяется качественно также как и $c_{v\beta}$. Увеличение температуры (когда $T > u_{\rm B}$) ведет к монотонному снижению величины a_{β} до значения, имеющего порядок периода кристаллической решетки. Соответственно $\lambda_{D\beta}$ асимптотически приближается к своему минимальному значению. Если зерна кристалла настолько малы, что приближаются к размерам ячеек кристаллической решетки, что характерно для аморфных тел, то величина a_{β} приближенно может рассматриваться как постоянная величина. Для таких тел λ_{DB} изменяется подобно величине $c_{\nu\beta}$.

Механизм электронной теплопроводности. Принимается, что при температурах, близких к нулю по шкале Кельвина, все электроны связаны с атомами и находятся на нулевом энергетическом уровне. Степени свободы атома отвечает один электрон. При подводе к телу энергии внутри тела возникает электромагнитное поле. Поглощая фотоны hv вследствие внутреннего фотоэффекта, валентные электроны частиц конденсированных тел распределяются по энергиям согласно закону (2)

$$W_{i_{\rm H3}} = \left[1 - \exp(-h_{\rm H}/(kT))\right] \left[1 - \exp(-A_3/(kT))\right]^{-1} \exp[-ih_{\rm H}/(kT)], \quad i = 0, 1, \dots, I_{\beta\nu}.$$
(16)

Достигнув энергии A_{2} , электрон отрывается от атома и становится свободным.

Энергия активации каждого из последовательно отрываемых от атома электронов существенно выше, чем у предыдущего. Это обусловлено тем, что отрицательно заряженные свободные электроны, а также положительный результирующий заряд иона, препятствуют отрыву связанных электронов. Принимая во внимание экспоненциальную зависимость плотности свободных электронов от энергии A_3 , можно положить, что атомы являются одновалентными. При этом величина $n_{\rm B}$ равна плотности атомов в металле $n_{\rm M} = c_{\rm M} / m_{\rm M}$, плотность ионов $n_{\rm u}$ равна плотности свободных электронов, т.е. $n_{\rm B} = n_{\rm M}$, $n_{\rm u} = n_{\rm c}$. Плотность связанных валентных электронов равна $n_{\rm CB} = n_{\rm B} - n_{\rm c}$.

Кинетическая энергия электрона в момент отрыва от атома должна быть ниже средней энергии свободной частицы газа при той же температуре. В дальнейшем энергия оторвавшегося электрона может возрастать вследствие поглощения фотонов электромагнитного поля. Будем полагать, что средняя кинетическая энергия свободного движения электрона пропорциональна кинетической энергии атома в газовой среде

$$E_{\rm c} = T(T)3kT/2 = m_{\rm g} w_{\rm c}^{2}/2, \qquad (17)$$

где m_3 — масса электрона; т — коэффициент неравновестности, учитывающий отклонение кинетической энергии электрона от энергии свободной нейтральной частицы системы в состоянии равновесия; $0 < \zeta \leq 1$. Это соотношение позволяет определить среднюю скорость w_c свободных электронов. Поскольку со скоростью w_c движутся только n_c электронов, а остальные валентные электроны неподвижны, средняя скорость валентных электронов равна $w_B = w_c / [n_c + (n_B - n_c)] = n_c w_c / n_B$.

Число валентных электронов из единичного объема, которые за единицу времени достигают энергии активации, находится согласно (3) по формуле

$$g_{3} = e_{3}n_{\rm CB} \left[\exp(A_{3}/kT) - 1 \right]^{-1}, \tag{18}$$

Число переходов связанного валентного электрона в свободное состояние за единицу времени составит $\Gamma = g_{2} / n_{B} = \varepsilon_{2} (1 - n_{c} / n_{B}) [\exp(A_{2} / kT) - 1]^{-1}$.

Среднее число переходов валентного электрона в связанное состояние вследствие столкновения с положительно заряженными ионами за единицу времени, в течение которого он проходит путь $w_{\rm B}$, равно $\Gamma' = w_{\rm B} n_{\rm c} y_{\rm H3}$, где $y_{\rm H3}$ — эффективное сечение поглощения иона по отношению к электрону. Средний путь, проходимый электроном от момента отрыва от атома до момента его поглощения ионом: $l_3 = w_{\rm B} / (w_{\rm B} n_{\rm c} y_{\rm H3}) = 1 / (n_{\rm c} y_{\rm H3})$.

При равновесии системы числа переходов свободных валентных электронов Г' в связанное состояние и в обратном направлении совпадают. Тогда из полученных выражений для Г и Г' находим

$$_{\rm c} / n_{\rm B} = 1/(1+\mu), \quad \mu = n_{\rm B} y_{\mu_3} w_{\rm c} [\exp(A_3 / kT) - 1] / e_3.$$
 (19)

Из (19) следует, что при $T \to 0$ плотность свободных электронов $n_c \to 0$, а при $T \to \infty$ плотность $n_c \to n_B$. Это соответствует современным представлениям о термоэлектронной эмиссии. По (19) определяется плотность n_c , а затем и g_3 .

Время между двумя переходами валентного электрона в свободное состояние равно $t_{\text{пер}} = 1/\Gamma = l_3 / w_{\text{в}}$. Это время складывается из времени пребывания валентного электрона в свободном $t_{\text{с}}$ и связанном $t_{\text{св}}$ состояниях, т.е. $t_{\text{пер}} = t_{\text{с}} - t_{\text{св}}$. Если средняя скорость движения свободного электрона равна $w_{\text{с}}$, а длина его свободного пробега $-l_3$, то $t_{\text{с}} = l_3 / w_{\text{с}}$.

Приведенные выше уравнения представляют собой замкнутую систему уравнений, позволяющую определить величины $n_{\rm B}$, $n_{\rm cB}$, $n_{\rm c}$, $n_{\rm u}$, $t_{\rm nep}$, $t_{\rm c}$, $t_{\rm cB}$, $w_{\rm B}$, $w_{\rm c}$, l_3 , g_3 , Γ , Γ' , $E_{\rm c}$ в зависимости от температуры *T*, плотности атомов в металле $n_{\rm M}$ и параметров A_3 , e_3 , τ , $y_{\rm H2}$.

Плотность потока энергии, переносимой свободными электронами через плоскость z в положительном и отрицательном направлении оси z в соответствии с элементарной кинетической теорией теплопроводности и уравнением (19) определяются соотношениями

$$q_3^+(z) = n_c(z-l_3)w_c(z-l_3)E_c(z-l_3)/6$$
, $q_3^-(z) = n_c(z+l_3)w_c(z+l_3)E_c(z+l_3)/6$.
Результирующая плотность теплового потока в направлении *z* равна

 $q_{\beta} = q_{\beta}^{+} - q_{\beta}^{-} = -l_{\mathfrak{g}} [\partial (n_{c} w_{c} E_{c}) / \partial z] / \mathfrak{Z} = -\lambda_{\mathfrak{g}} \partial T / \partial z .$ ⁽²⁰⁾

Отсюда следует, что электронная теплопроводность

$$\pi_{3} = \frac{1}{3} l_{3} \frac{\partial (n_{c} w_{c} E_{c})}{\partial T}.$$
(21)

Если в формуле (21) положить, что $n_c = n_B$, $\partial(w_c E_c) \approx w_3 \partial E_3 / \partial T = 3w_3 k/2$, тогда она переходит в формулу, полученную в классической теории Друде. Результаты численных экспериментов, связанных с согласованием формулы (21) с экспериментальными данными, показали, что отклонение скорости свободного электрона w_c от средней скорости w_3 электронного газа в состоянии равновесия при различных температурах может быть описано следующей линейной зависимостью $w_c = w_3(1-B_3T)$, $B_3 = const$, $0 < \beta_3 < 1$. Величина β_3 имеет порядок $1/T_{n\pi}$, где $T_{n\pi}$ — температура плавления проводника. При этом величина $\varsigma(T)$ в (17) принимает вид $\varsigma(T) = (1-\beta_3 T)^2$.

Результаты расчетов на базе уравнений (20)–(37) показали, что длина свободного пробега электронов l_3 возрастает с понижением температуры. Однако величина l_3 ограничена размерами зерен кристалла $L_{\rm kp}$, и если температура понижается дальше, то l_3 должна сохранять значение $L_{\rm kp}$. На рис. 1 сплошными линиями представлены результаты расчета по формуле (21) температурных зависимостей электронной теплопроводности π_3 для различных металлов – железа, меди, алюминия; серебра. Штриховыми кривыми представлены экспериментальные результаты [8]. Расчетные и экспериментальные данные качественно и количественно согласуются в широком диапазоне температур, включающем и очень низкие.



Кривые 1 и 1' – для алюминия; 2 и 2' – для серебра; 3 и 3' – для меди; 4 и 4' – для железа; Сплошные линии – расчет; штриховые линии – эксперимент Рис.1. – Зависимости электронной теплопроводности λ₂ от температуры T для

различных металлов.

Литература

- 1. Никитенко Н. И. Теория тепломассопереноса. Киев: Наук. Думка, -1983. -352 с.
- Никитенко Н. И. Проблемы радиационной теории тепло- и массопереноса в твердых и жидких средах // ИФЖ. 2000. –Т. 73, –№ 4. –С. 851 – 860.
- 3. Никитенко Н. И. Исследование динамики испарения конденсированных тел на основе закона интенсивности спектрального излучения частиц // ИФЖ. 2002. –Т. 75, –№ 3. –С. 128 – 134.

- Никитенко Н. И. Закон интенсивности спектрального излучения частиц и связанные с ним проблемы тепло – и массопереноса. Пятый Минский международный форум по тепло – и массообмену. – Тез. Докладов. Минск. –2004. – С. 204 – 206.
- 5. Никитенко Н. И. О взаимосвязи между радиационными характеристиками частиц тела и поля теплового излучения // Доповіді НАН України. 2004. № 10. С. 100 108
- 6. Мучник Г. Ф., Рубашов И. Б. Методы теории теплообмена. М.: Высшая школа, 1970. –286 с.
- 7. Яворский Б. М., Детлаф А. А. Справочник по физике.-М.: Наука, 1974. 943 с.
- 8. Теплопроводность твердых тел. Справочник. Под ред. проф. Охотина А. С. М: Энергоатомиздат.– 1984. 321 с.

УДК 664.834.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА СУШКИ В ТЕПЛОМАССОБМЕННЫХ МОДУЛЯХ С ВНУТРЕННИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

Потапов В.А., д-р технических наук, профессор; Якушенко Е.Н., ассист., Харьковский государственный университет питания и торговли, г. Харьков

В статье рассмотрены вопросы энергоэффективности сушильных установок, а также рассмотрены способы повышения энергоэффективности СТП-сушилок с различными видами нагревателей. The article discusses efficiency dryers, as well as addressed-how to improve energy efficiency MHT-drying with different types of heaters.

Ключевые слова: энергоэффективность, сушка, тепломассообменный модуль, СТП-сушка.

В настоящее время для определения технических характеристик сушильных установок используются следующие показатели: производительность по испаренной влаге, удельные затраты энергии на сушку, кпд сушилки. Первые два из этих показателей позволяют сравнивать различные сушилки или по производительности или по затратам энергии на процесс сушки, однако не дают возможность оценить эффективность использования этой энергии. Коэффициент полезного действия показывает эффективность использования энергии, однако не дает ответа на вопрос о производительности сушилки. По нашему мнению, для оценки эффективности использования энергии в процессе сушки необходимо использовать следующий показатель: производительность сушилки по испаренной влаги отнесенную к удельным затратам энергии на процесс

$$E_{\phi} = \frac{\Delta m / \Delta \tau}{Q / \Delta m},\tag{1}$$

где E_{ϕ} — показатель энергоэффективности, (кг/с)/(Дж/кг);

∆*т* — масса влаги удаленная в процессе сушки, кг;

 $\Delta \tau$ — продолжительность процесса сушки. с;

Q — полные затраты энергии на процесс, Дж.

Введение такого показателя позволяет сравнивать различные сушилки по эффективности использования энергии на процесс удаления влаги. Максимизация этого показателя с экономической точки зрения эквивалентно максимизации рентабельности использования сушилки.

Проведенный расчет по энергоэффективности основных типов сушилок показал, что наибольший показатель энергоэффективности – у зерносушильного агрегата шахтенного типа, наименьший – у сублимационной сушилки (рис.1).